

KT916A, KT916B

ТРАНЗИСТОРЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ СВЧ HIGH-POWER MICROWAVE TRANSISTORS

Транзисторы KT916A, KT916B предназначены для работы в усилительных схемах и автогенераторах в непрерывном режиме на частотах свыше 200 МГц аппаратуры широкого применения.

Si-n-p-n-EP

The KT916A, KT916B transistors are designed for use in amplifier circuits and in autogenerators in CW operation at frequencies above 200 MHz in a wide range of applications.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДАННЫЕ $t_{case} = -60...+100^{\circ}C$
MAXIMUM RATINGS

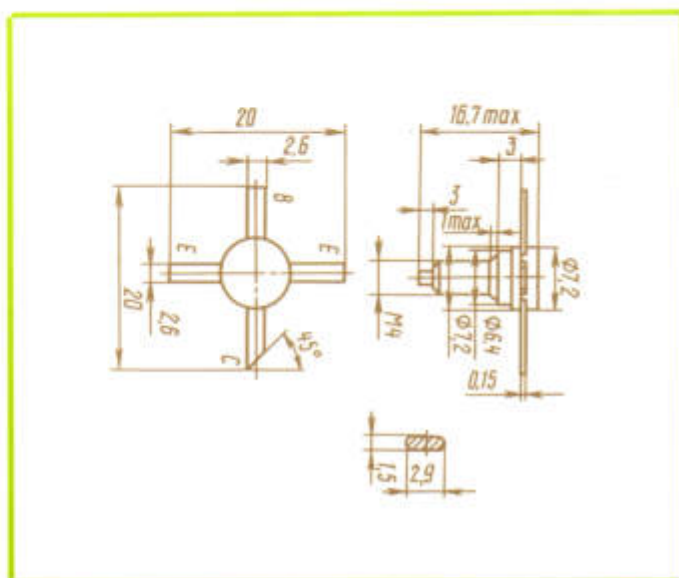
$U_{CB\ max.}$ ($t_{case} \geq 25^{\circ}C$), V	55
$U_{CE\ max.}$ ($R_{EB} = 10\ \Omega$, $t_{case} > 25^{\circ}C$), V	55
$U_{EB\ max.}$, V	3,5
$I_C\ max.$, A	2
$I_{CM\ max.}$ ($t_p \leq 5\ ns$, $Q > 10$), A	4
$I_B\ max.$, A	1
$P_{C^{**}}$ ($t_{case} < 25^{\circ}C$, $f \geq 200\ MHz$), W	30
$t_{j\ max.}$, $^{\circ}C$	160

* Динамический режим.
Dynamic operation.

**При $t_{case} > 25^{\circ}C \Rightarrow P_{C\ max.} = \frac{160 - t_{case}}{4,5}$

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	KT916A	KT916B	Режимы Conditions
1	2	3	4
I_{CER} , mA	≤ 25	≤ 40	$U_{CE} = 55\ V$ $R_{EB} = 10\ \Omega$
I_{EBO} , mA	≤ 4	≤ 4	$U_{EB} = 3,5\ V$
f_T , MHz	≥ 1100	≥ 900	$U_{CE} = 10\ V$ $I_C = 1,5\ A$ $f = 100\ MHz$



1	2	3	4
$U_{CE\ sat.}$, V	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$	$I_C = 250\ mA$ $I_B = 30\ mA$
$U_{BE\ sat.}$, V	≤ 1	≤ 1	
G_p , dB	$\geq 2,25$	$\geq 1,85$	$P_{out} = 20\ W$ $P_{out} = 16\ W$ } $U_{CE} = 28\ V$ $f = 1\ GHz$
η_C , %	≥ 45	≥ 45	$P_{out} = 20\ W$ $P_{out} = 16\ W$ } $U_{CE} = 28\ V$ $f = 1\ GHz$
C_c , pF	≤ 20	≤ 20	$U_{CB} = 30\ V$ $f = 10\ MHz$
τ_c , ps	≤ 10	≤ 10	$U_{CB} = 10\ V$ $I_E = 100\ mA$ $f = 30\ MHz$

